

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-118445

(43)公開日 平成6年(1994)4月28日

(51)Int.Cl.
G 02 F 1/136
1/13
H 01 L 27/12
29/734

識別記号
5000
101
A

9056-4M

H 01 L 29/78 311 A

審査請求 未請求 請求項の数3(全10頁)

技術表示箇所

(21)出願番号 特願平4-271621
(22)出願日 平成4年(1992)10月9日

(71)出願人 000005223
富士通株式会社
神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地
(72)発明者 川井 信
神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地
富士通株式会社内
加藤 真也
神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地
富士通株式会社内
(73)発明者 井上 淳
神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地
富士通株式会社内
(74)代理人 宮川 岳三

(54)【発明の名稱】 液晶表示装置の製造方法

(57)【要約】

【目的】液晶駆動用 TFT のある液晶表示装置に適し、TFT の動作半導体層を薄くし、バターニング用マスクの作成工程の簡略化を図り、生産性を向上する。

【構成】ゲート電極16の上に複数したゲート絶縁膜19と動作半導体層20とチャネル部構造21Aをバターニングする際にボブ型イメージ・リバーサル・レジスト22を使用し、ゲート電極16を含むトランジスタ形成領域にあるぞのレジスト22の上層に光を照射し、リバーサル・ペイント部分を遮る不能な変更部22Aとした後、透光部11の上と下から光を照射し、変更部22Aとゲート電極16との間を除くイメージ・リバーサル・レジスト22を光照射状態にする工程と、現像により前記イメージ・リバーサル・レジスト22を断面T字型のパターンにする工程と、そのパターンをマスクに用いてチャネル部構造21Aを等方向エッチングし、動作半導体層20とゲート絶縁膜19を異方向エッチングするバターニング工程を含む。

